

## 四、 高斯定理

### (一) . 电力线(电场线)

用一族空间曲线形象描述场强分布

通常把这些曲线称为电场线(electric field line)或电力线 (electric line of force)

#### 1. 规定

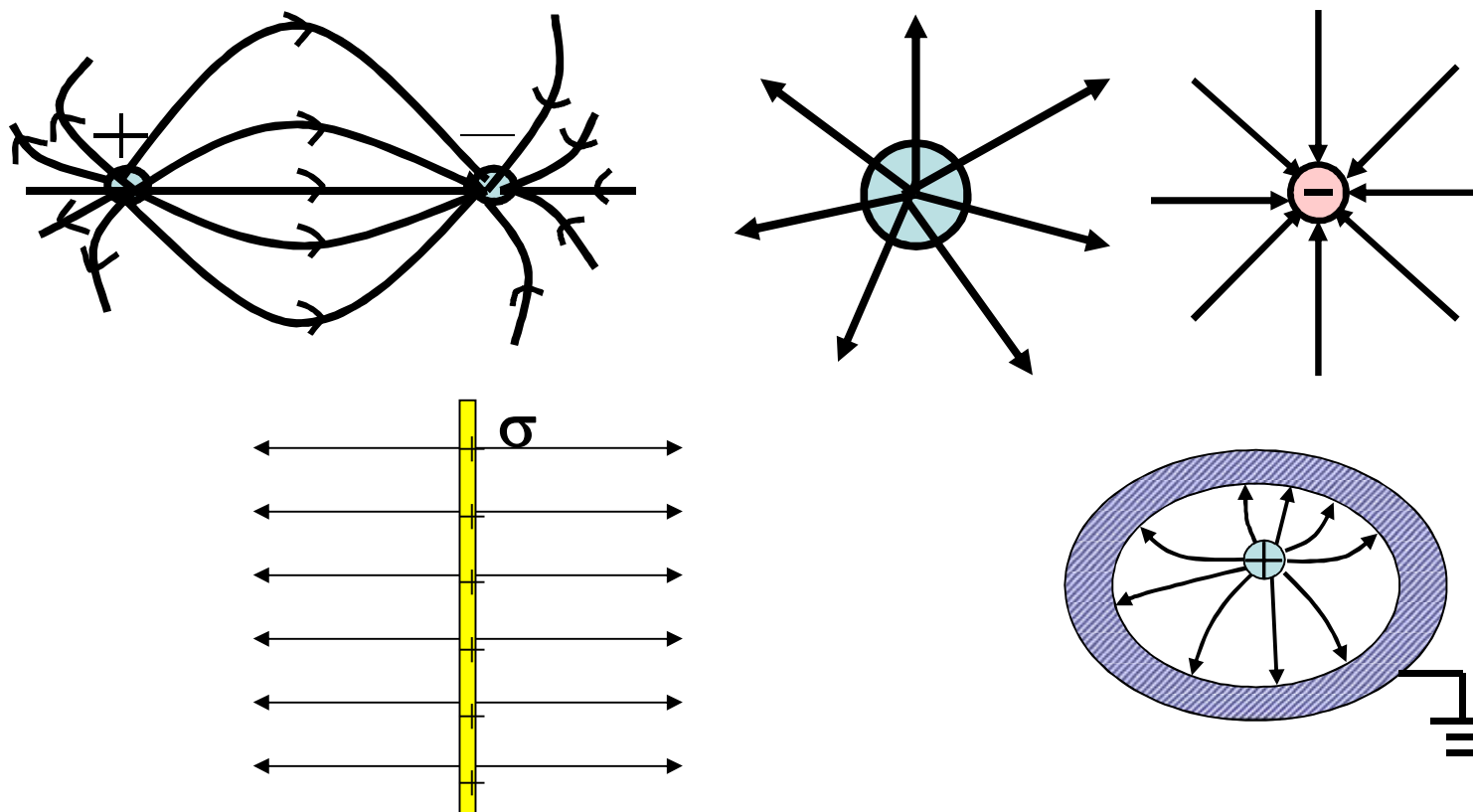
**方向：**电力线上每一点的切线方向表示该点场强的方向

**大小：**电力线的疏密表示场强的大小。

在电场中任一点，取一垂直于该点场强方向的面积元，使通过单位面积的电力线数目，等于该点场强的量值。

## 2. 电力线的性质

- 1) 电力线起始于正电荷(或无穷远处), 终止于负电荷, 不会在没有电荷处中断;
- 2) 两条电场线不会相交; 电力线不会形成闭合曲线。

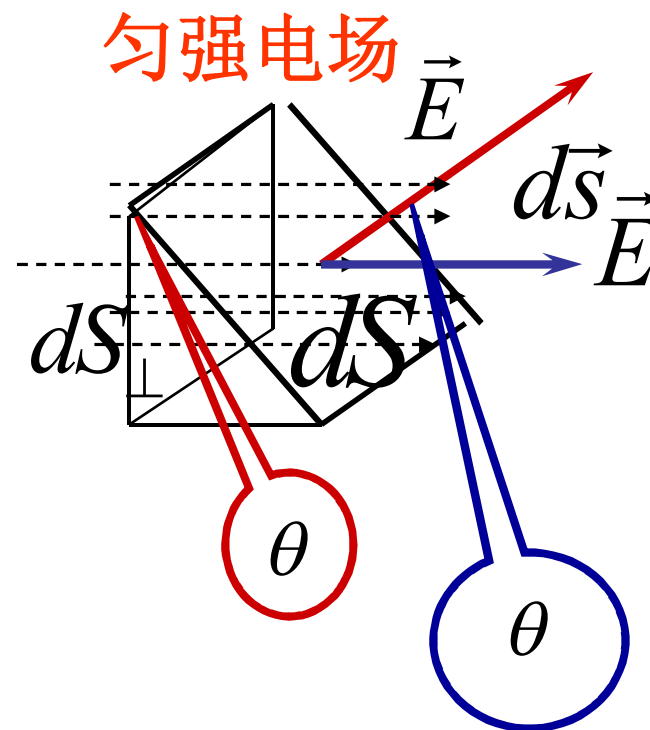


### 3. 电力线与场强关系

$$E = \frac{d\phi}{dS_{\perp}} \quad d\phi = E ds_{\perp}$$

若面积元不垂直电场强度，

电场强度与电力线条数、面积元的关系怎样？



由图可知 通过  $ds$  和  $ds_{\perp}$  电力线条数相同

$$d\vec{S} = ds \hat{n}$$

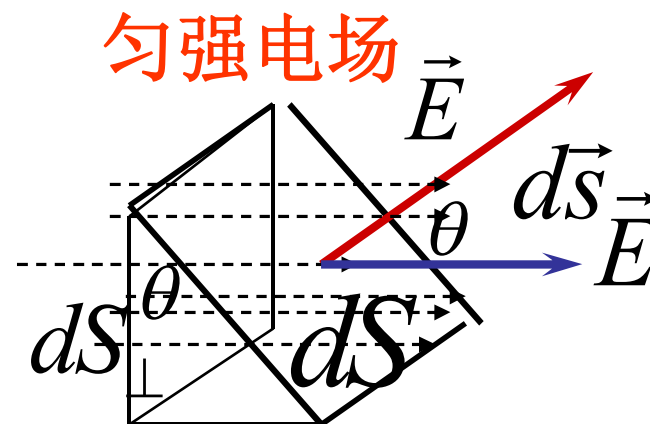
$$d\phi_e = E ds_{\perp} = E ds \cos \theta \Rightarrow d\phi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

## (二.) 电通量

藉助电力线认识电通量

通过任一面的电力线根（条）数

即为通过此面元的电通量



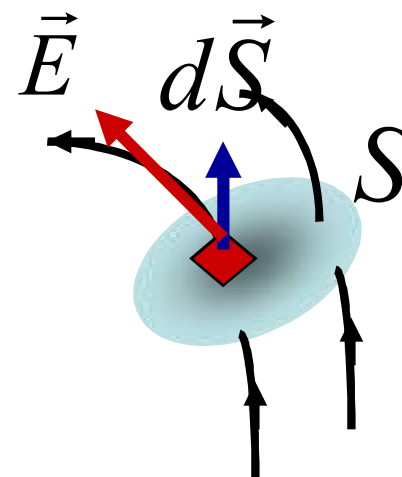
$$d\phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

通过任意曲面的电通量:

把曲面分成许多个面积元

每一面元处视为匀强电场

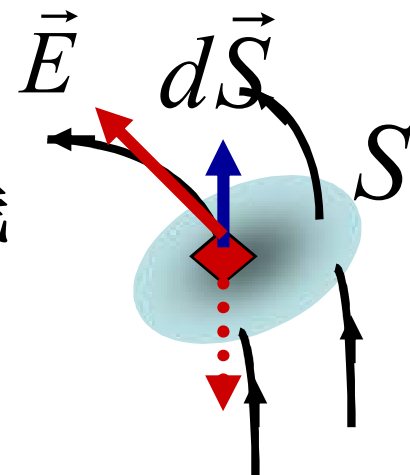
$$\phi_e = \int_S d\phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$





正与负

取决于面元的法线  
方向的选取



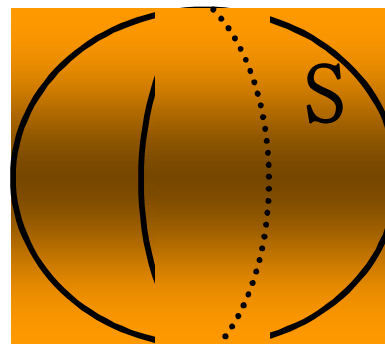
$$1. d\phi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

如前图 知  $\vec{E} \cdot d\vec{S} > 0$   $\theta < \frac{\pi}{2}$

若如红虚箭头所示 则  $\vec{E} \cdot d\vec{S} < 0$   $\theta > \frac{\pi}{2}$

2. 通过闭合面的电通量

$$\phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

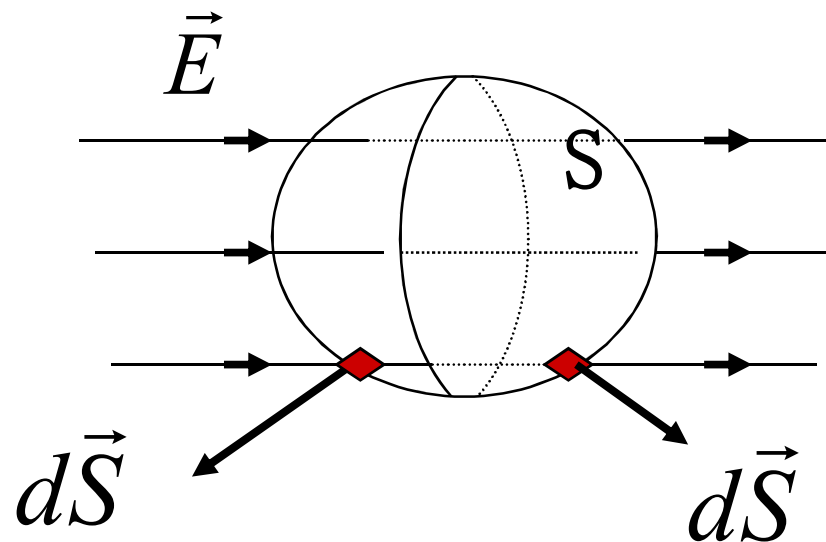


规定：对闭合曲面，面元正方向由闭合面内指向面外  
外法线

$$\phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

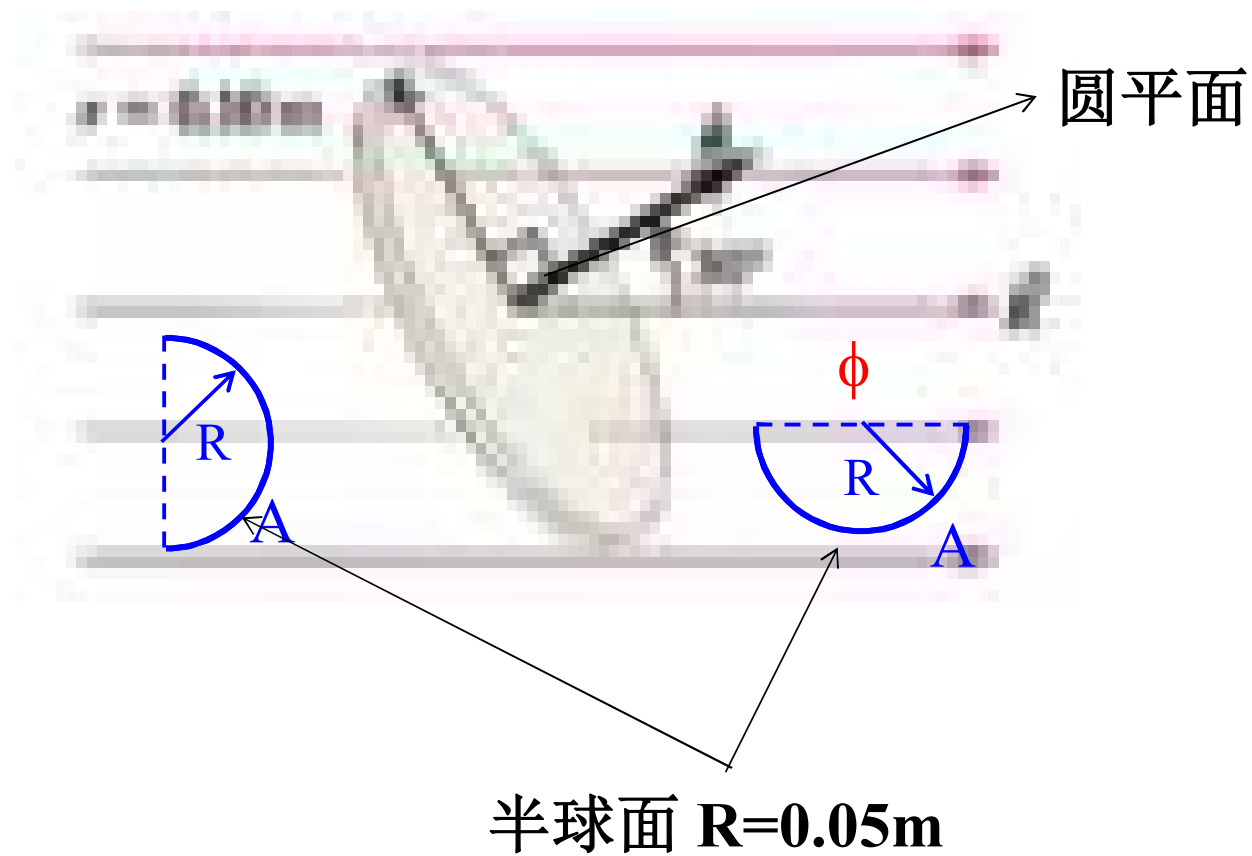
$\vec{E} \cdot d\vec{S} < 0$  电力线穿入

$\vec{E} \cdot d\vec{S} > 0$  电力线穿出



$$\phi_e \begin{cases} > 0 & \text{穿出的电力线条数大于穿进的电力线条数} & \text{多正电荷} \\ = 0 & \text{穿出的电力线条数等于穿进的电力线条数} & \text{无多余电荷} \\ < 0 & \text{穿出的电力线条数小于穿进的电力线条数} & \text{多负电荷} \end{cases}$$

均匀电场  $E=2.0 \times 10^3 \text{ N/C}$



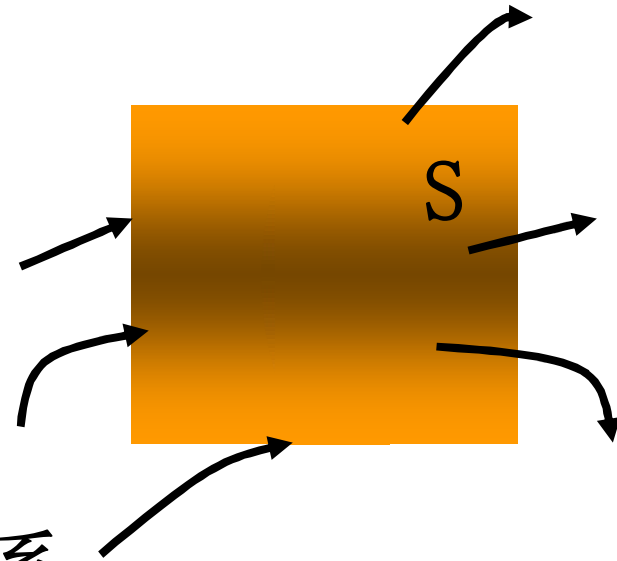
求通过各面的电通量。

### (三) . 静电场的高斯定理 (Gauss theorem)

#### 1. 表述

在真空中的静电场内，任一闭合面的电通量等于这闭合面所包围的电量的代数和除以  $\epsilon_0$  。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_{i\text{内}}}{\epsilon_0}$$



用电通量表示电场和场源电荷关系

利用电通量概念、库仑定律、场叠加原理



## 2、高斯定理的证明

### (1) 电点荷的场

点电荷在闭合球面中心时

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oint_s \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} ds \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_s ds = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

点电荷在任意闭合曲面内时

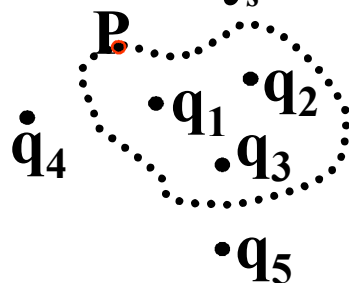
点电荷在任意闭合曲面外时

$$\Phi_e = \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

### (2) 电荷系的场中任一闭合曲面

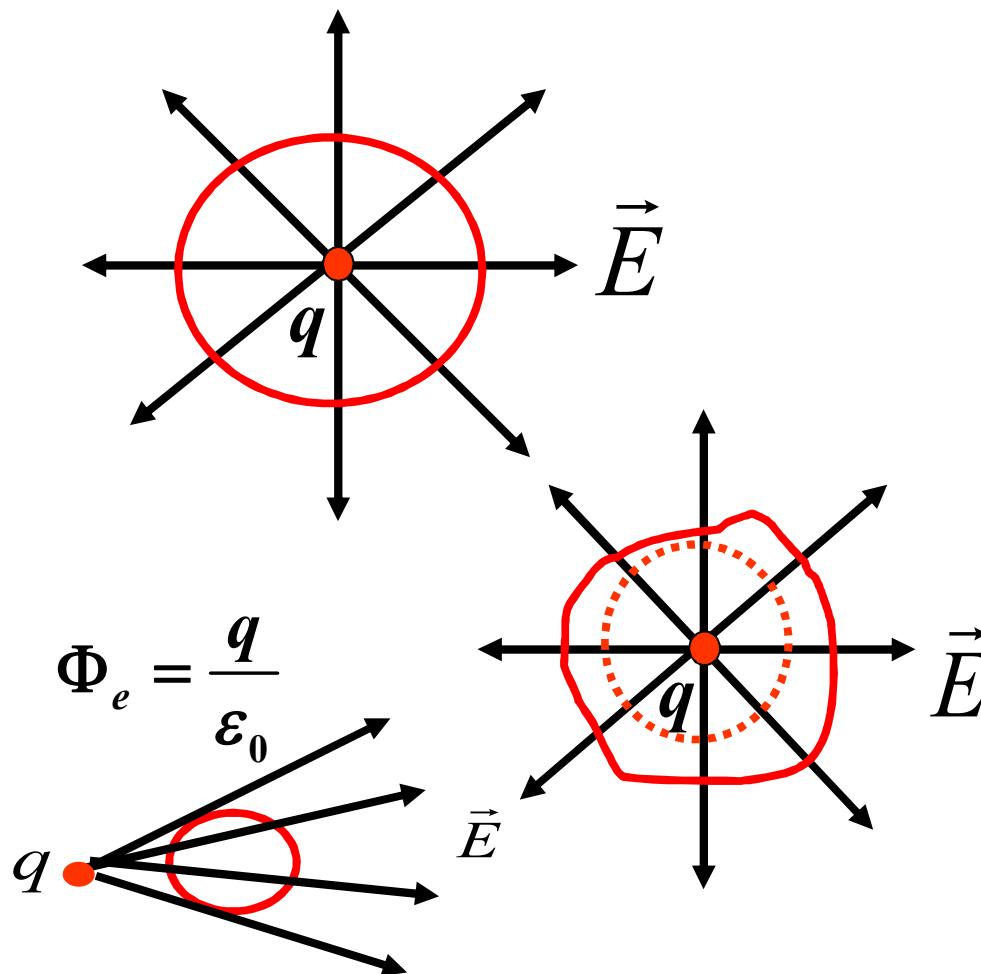
$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oint_s \vec{E}_1 \cdot d\vec{s} + \oint_s \vec{E}_2 \cdot d\vec{s} + \dots + \oint_s \vec{E}_n \cdot d\vec{s} \\ &= \Phi_{e1} + \Phi_{e2} + \dots + \Phi_{en}\end{aligned}$$

$$\Phi_e = \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{i\text{内}}$$



### (3) 任意场中任一闭合曲面

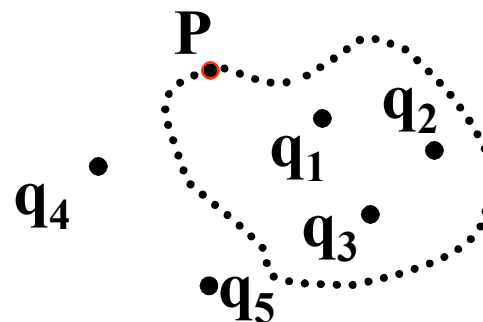
$$\Phi_e = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{\text{内}} dq$$



# 讨论高斯定理

1. 对任意形状的闭合曲面都成立

$$\Phi_e = \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{i \text{ 内}}$$



2. 电场强度  $\vec{E}$  是由闭合曲面内、外的所有电荷决定的,

但对电通量  $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s}$  来说  $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q_1 + q_2 + q_3}{\epsilon_0}$

只有闭合面内的电荷对电通量有贡献

3. 高斯定理是描述静电场性质的基本方程

有源场

4. 高斯定量的微分形式

$$\oint_s \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_v \nabla \cdot \vec{A} dV$$

数学高斯公式

$$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\begin{aligned} \Phi_e &= \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_v \nabla \cdot \vec{E} dV \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_v dq = \frac{1}{\epsilon_0} \int_v \rho dV \end{aligned}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

散度

#### (四) . 高斯定理在解场方面的应用

对  $Q$  的分布具有某种对称性的情况下利用高斯定理求  $E$  较方便，一般解题步骤：

- 1、根据电荷分布的对称性分析电场分布的对称性  
常见的电量分布的对称性：

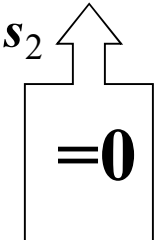
	球对称	柱对称	面对称
均匀带电的	球体	无限长	无限大
	球面	柱体	平板
	(点电荷)	柱面	平面
		带电线	

## 2、选择合适的封闭积分曲面(常叫高斯面)

- 1) 使电场强度  $E$  的矢量处处垂直于高斯面，且在此面上处处相等。

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \oint ds = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

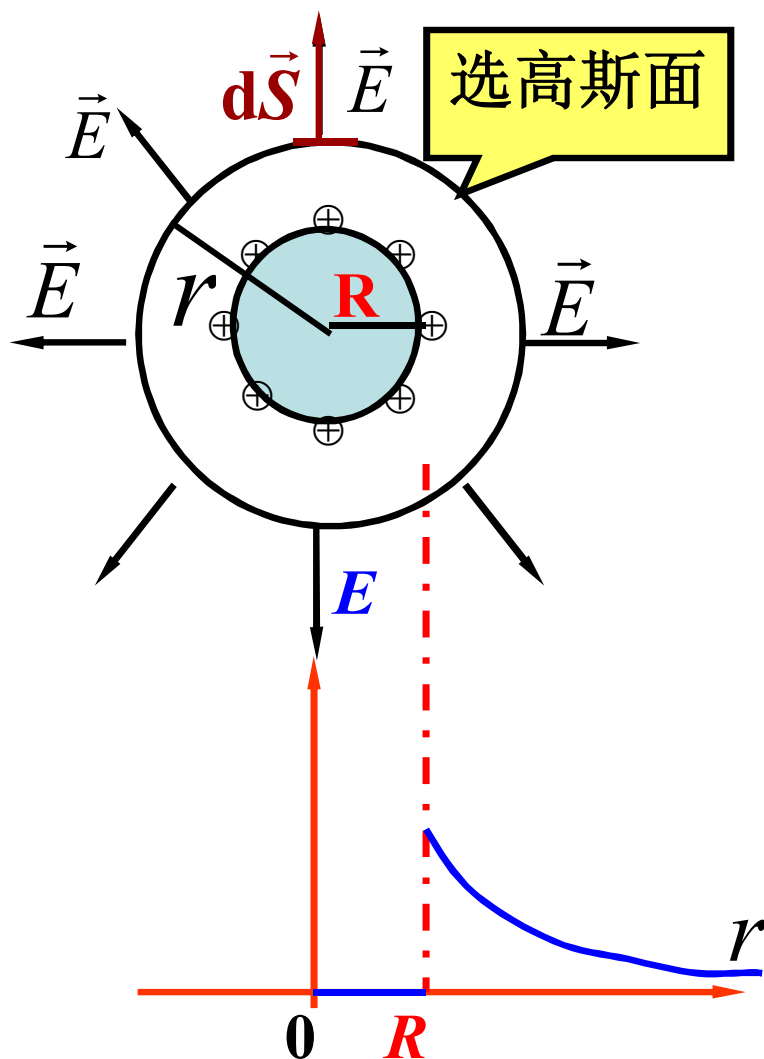
- 2) 使高斯面的一部分与电场平行，则电力线不穿过高斯面的此部分。

$$\int_{s_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{s_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$


例1 求电量为 $Q$ 、半径为 $R$ 的均匀带电球面的场强分布。



解： 源球对称  $\Rightarrow$  场球对称



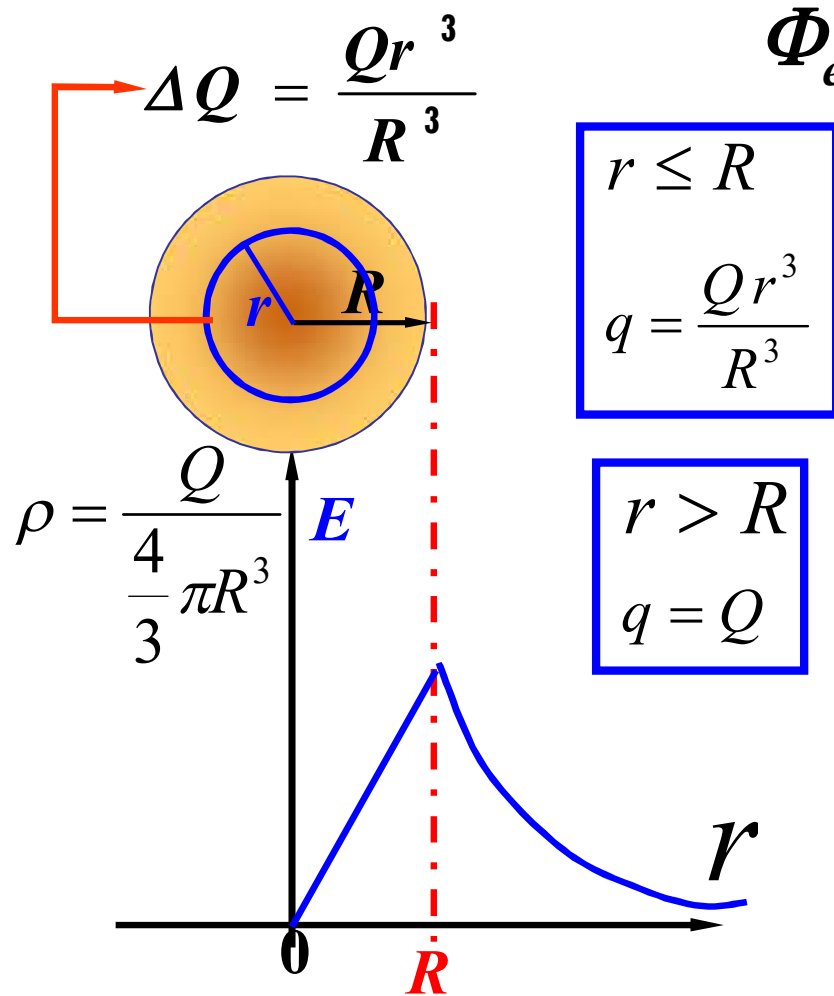
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{Q}{\epsilon_0} & (r > R) \end{cases}$$

$$\Downarrow = E \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2$$

$$E = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$

例2 求：电量为 $Q$ 、半径为 $R$ 的均匀带电球体的场强分布。 ☆

解：选择高斯面——同心球面



$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} \frac{Qr^3}{\epsilon_0 R^3} & (r < R) \\ \frac{Q}{\epsilon_0} & (r > R) \end{cases}$$

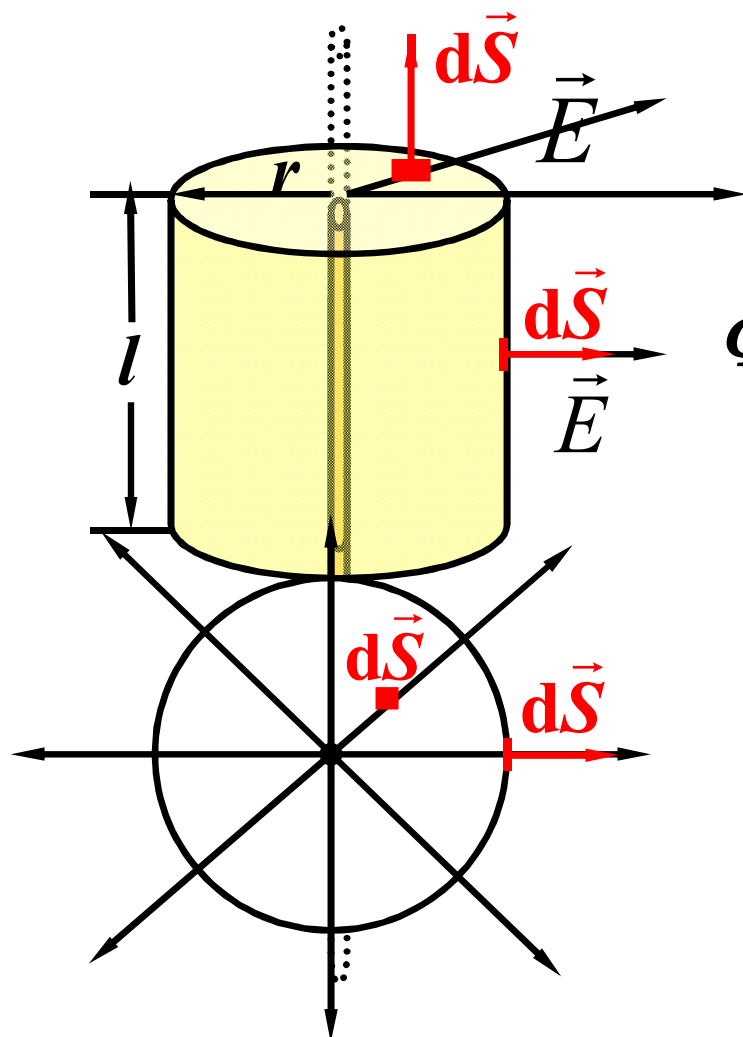
$$= E \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2$$

$$E = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} & (r \leq R) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$

例3 求：电荷线密度为 $\lambda$ 的无限长带电直线的场强分布。



解：选择高斯面——同轴柱面



上下底面  $\vec{E} \perp d\vec{S}$   
侧面  $\vec{E} \parallel d\vec{S}$   
且同一柱面上 $E$ 大小相等

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{l\lambda}{\epsilon_0}$$



$$= \int_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{底}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= E \cdot 2\pi r l + 0$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

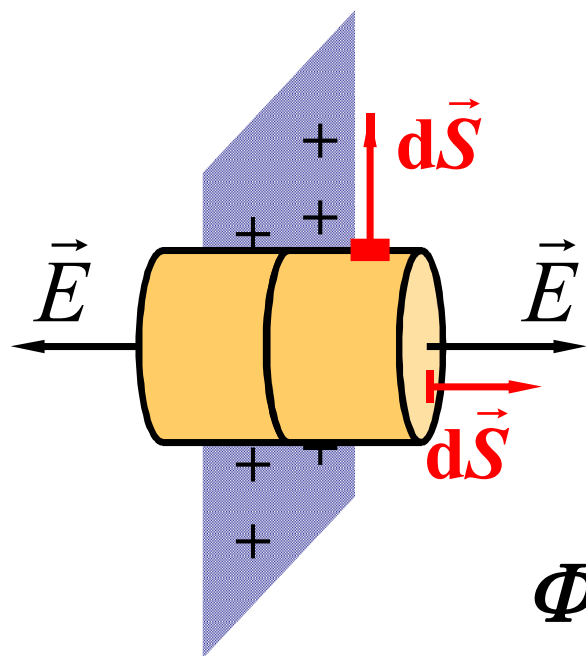
$$q = l\lambda$$

# 例4



求：电荷面密度为 $\sigma$ 的无限大均匀带电平面的场强分布。

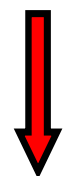
解：选择高斯面——  
与平面正交对称的柱面



$\left\{ \begin{array}{l} \text{底面 } \vec{E} \uparrow \uparrow \vec{dS} \text{ 且大小相等;} \\ \text{侧面 } \vec{E} \perp \vec{dS} \end{array} \right.$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

$q = \Delta S \sigma$



$$= 2 \Delta S E$$

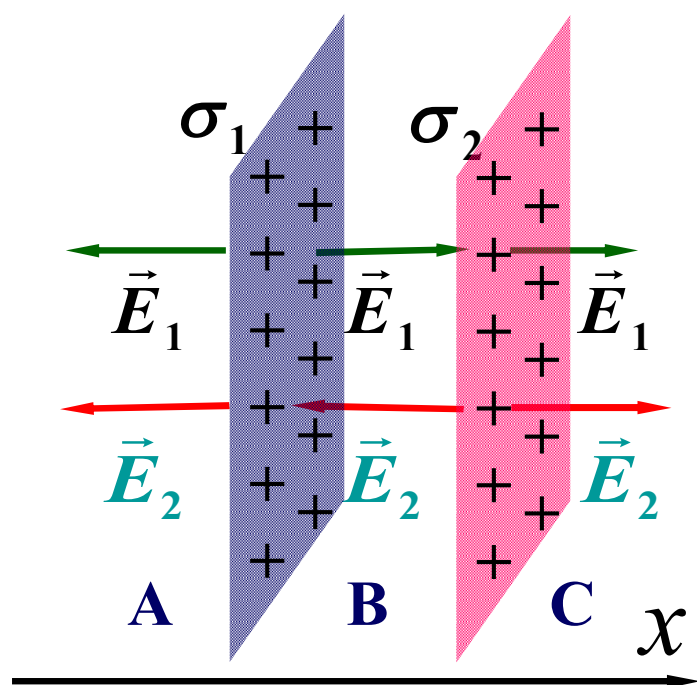
$E = \frac{\sigma}{2 \epsilon_0}$



当场源是几个具有对称性的带电体时，可用高斯定理  
分别求各带电体单独存在时的场强，再作矢量叠加。



**例5** 求：电荷面密度分别为 $\sigma_1$ 、 $\sigma_2$ 两个平行放置  
的无限大均匀带电平面的场强分布。

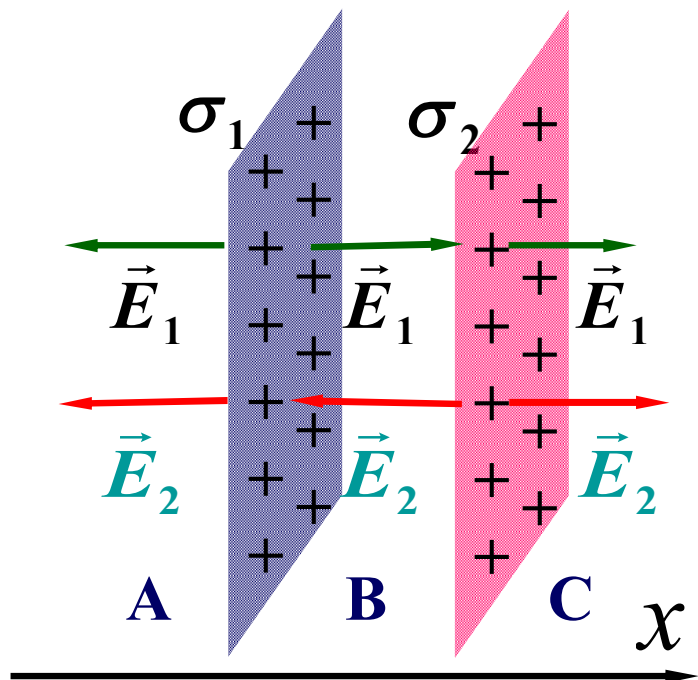


解：  $E_1 = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0}$        $E_2 = \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0}$

$$\vec{E}_A = -\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2\epsilon_0} \vec{i}$$

$$\vec{E}_B = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2\epsilon_0} \vec{i}$$

$$\vec{E}_C = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2\epsilon_0} \vec{i}$$



$$\vec{E}_A = -\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2\epsilon_0} \vec{i}$$

$$\vec{E}_B = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2\epsilon_0} \vec{i}$$

$$\vec{E}_C = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2\epsilon_0} \vec{i}$$



当  $\sigma_1 = -\sigma_2 = \sigma$

$$E_A = E_C = 0$$

带电平板电容器间的场强

$$E_B = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

例6. 已知：均匀带电球壳的 $\rho$ （或 $q$ ）及 $R_1$ 、 $R_2$

求：电场强度的分布。

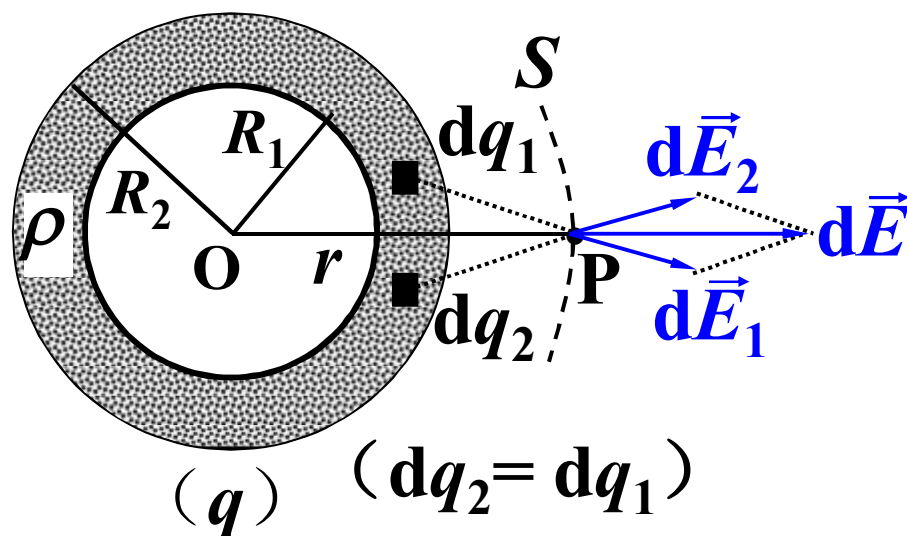


解： 分析对称性

$$d\vec{E} = d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2$$

$$dE_1 = dE_2$$

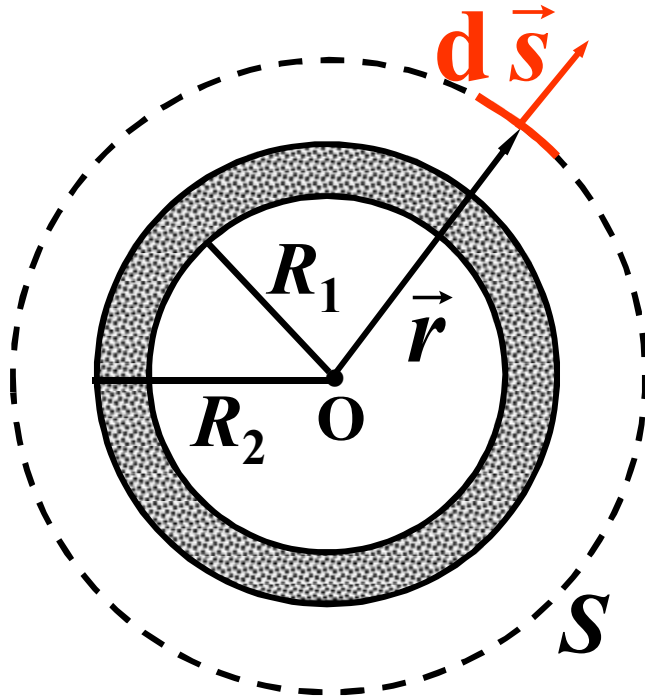
方向是关于 $OP$  对称的



球对称

$$\vec{E} = E(r) \cdot \hat{r}$$

选高斯面 $S$ 为与带电球壳同心的球面

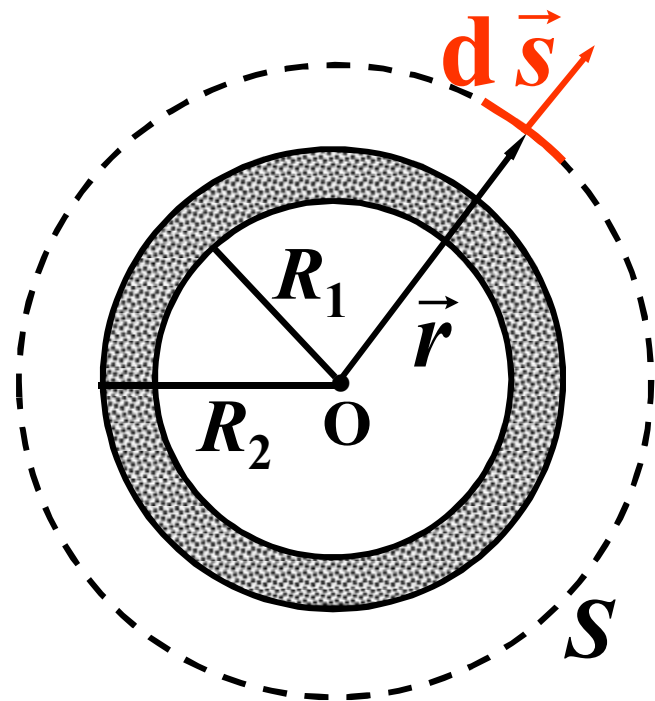


$$\begin{aligned}\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oint_S E(r) \hat{r} \cdot d\vec{S} \\ &= \oint_S E(r) dS = E \oint_S dS \\ &= 4\pi r^2 \cdot E(r)\end{aligned}$$

$$\text{又} \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

所以 
$$\vec{E} = E(r) \hat{r} = \frac{q_{\text{内}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$r < R_1, \quad q_{\text{内}} = 0; \quad E = 0$$



$$R_1 < r < R_2,$$



$$q_{\text{内}} = \frac{4\pi}{3}(r^3 - R_1^3)\rho,$$

$$\text{有} \quad \vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \left( r - \frac{R_1^3}{r^2} \right) \hat{r}$$

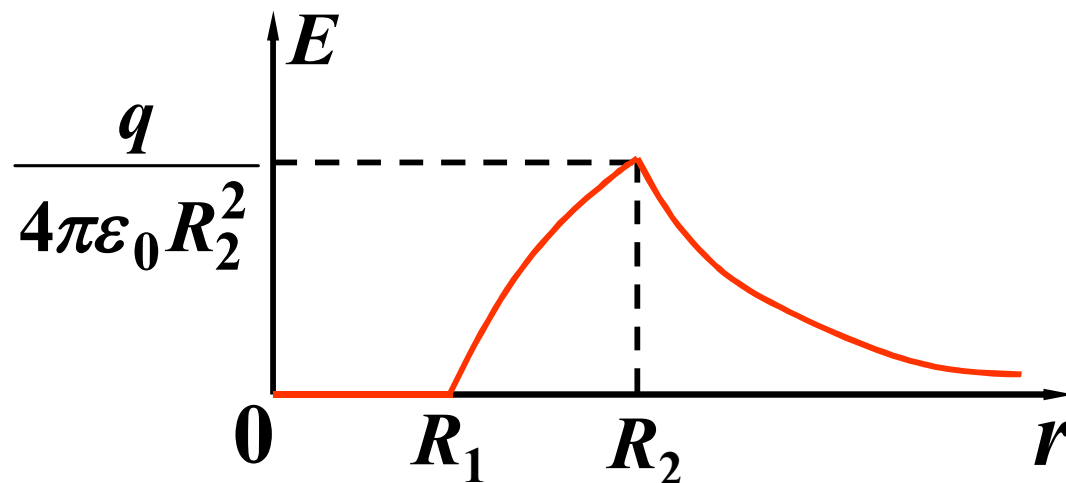
$$r > R_2, \quad q_{\text{内}} = \frac{4\pi}{3}(R_2^3 - R_1^3)\rho = q,$$

$$\text{有} \quad \vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r} \quad (\text{同点电荷的电场})$$

## 讨论

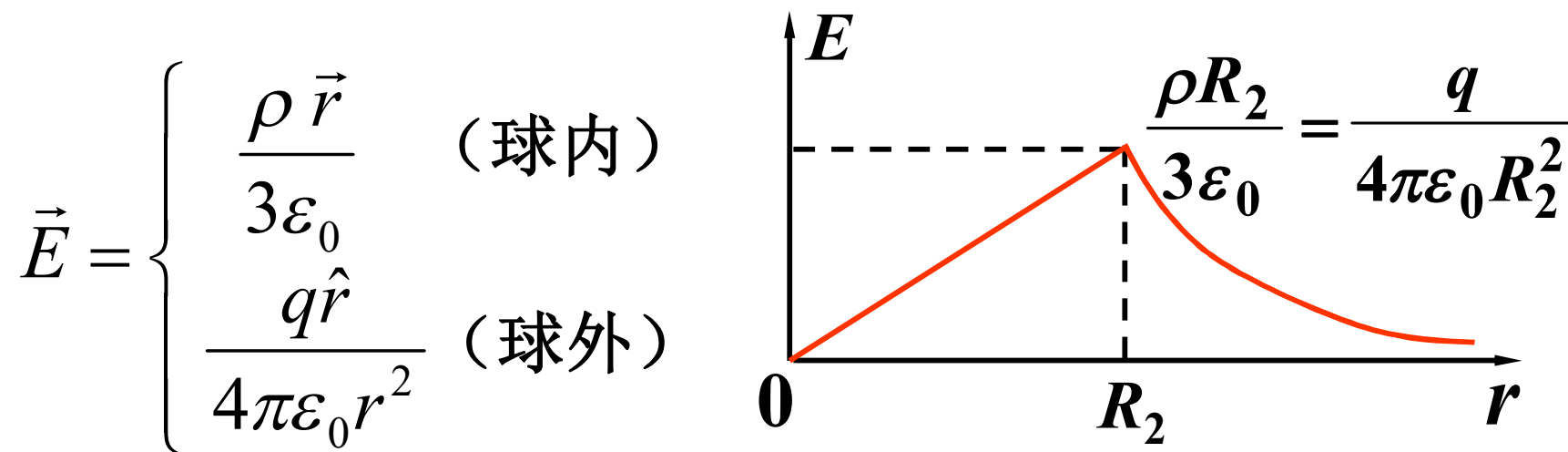


### 1. $E$ 的分布



### 2. 特殊情况

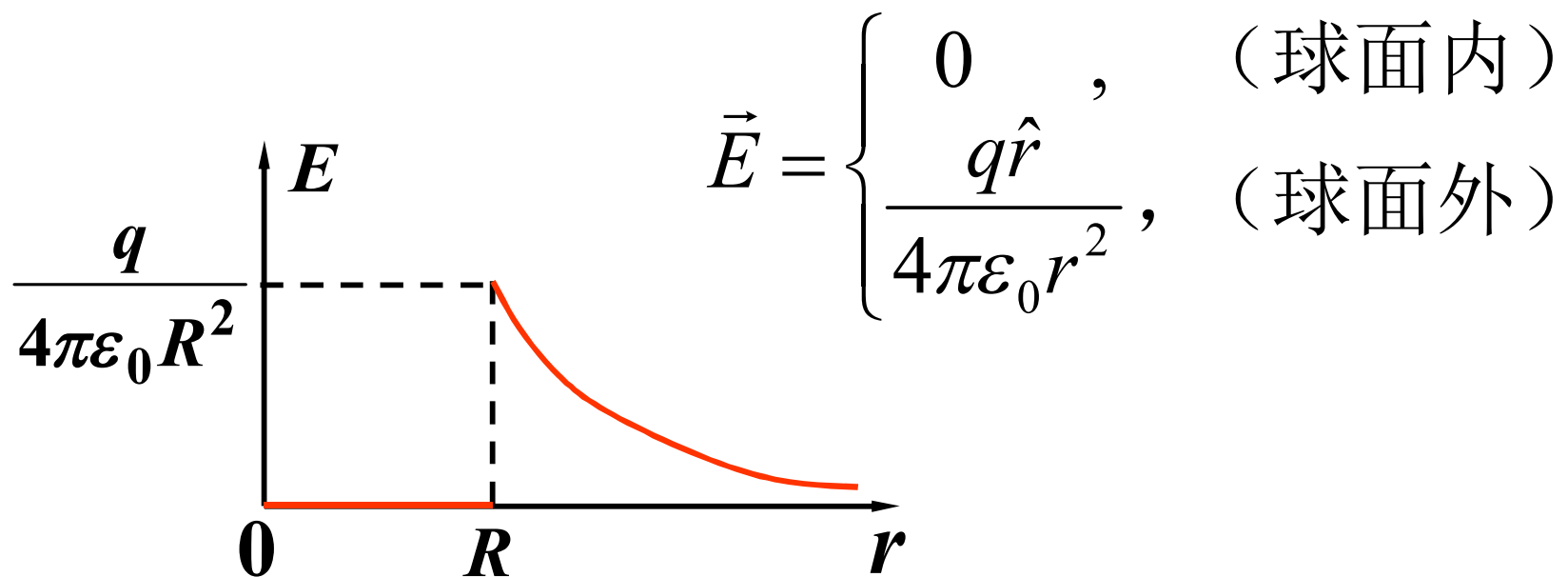
1) 令  $R_1 = 0$ , 得均匀带电球的情形:



2) 令  $R_1 = R_2 = R$ , 且  $q$  不变,



得均匀带电球面的情形:



在  $r = R$  处  $E$  不连续,

这是因为忽略了电荷厚度所致。

**小结** 应用高斯定理求场强的要点:



**适用对象:** 有球、柱、平面对称的**某些**电荷分布。

**方法要点:** (1) 分析  $\vec{E}$  的对称性;

(2) 选取高斯面的原则:

1) 需通过待求  $\vec{E}$  的区域;

2) 在  $S$  上待求  $\vec{E}$  处,  $\vec{E} // \mathrm{d}\vec{s}$  且等大,

使得  $\int \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = E \int \mathrm{d}s$ ,

其余处必须有  $\vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = 0$   $\left\{ \begin{array}{l} \text{或 } E = 0, \\ \text{或 } \vec{E} \perp \mathrm{d}\vec{s}. \end{array} \right.$